

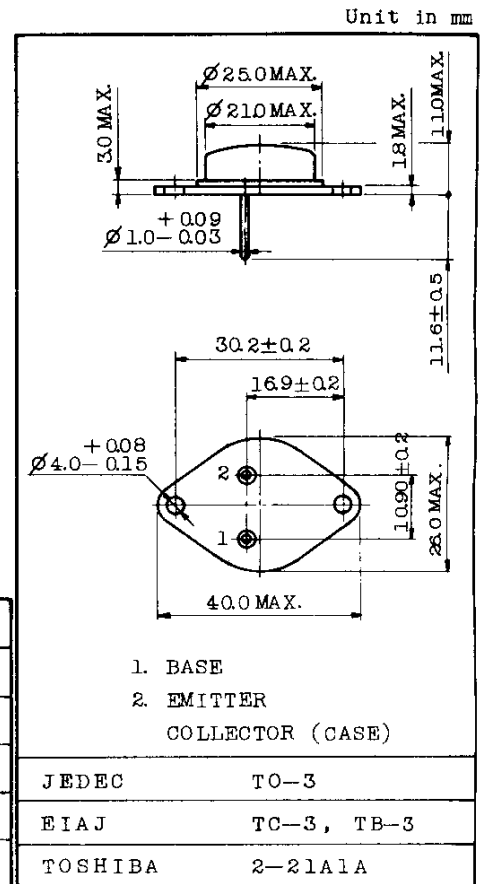
2SD551

シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

- 電力増幅用
- Power Amplifier Applications.
- 高耐圧です。: $V_{CEO} = 150V$ (Min.)
- トランジション周波数が高い。: $f_T = 15MHz$ (Typ.)
- 2SB681とコンプリメンタリになります。
- 80W ハイファイオーディオアンプ出力段に最適です。
- Complementary to 2SB681.
- Recommended for 80W High-Fidelity Audio Frequency Amplifier Output Stage.

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	150	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	12	A
エミッタ電流	I_E	-12	A
コレクタ損失 (Tc = 25°C)	P_C	100	W
接合温度	T_j	< 150	°C
保存温度	T_{stg}	-65 ~ 150	°C



アクセサリは AC73 を適用
MOUNTING KIT No. AC73

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしゅ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 100V, I_E = 0$	—	—	100	μA
エミッタしゅ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$	—	—	100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 0.1A, I_B = 0$	150	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 10mA, I_C = 0$	5	—	—	V
直流電流増幅率	h_{FE} (Note)	$V_{CE} = 5V, I_C = 1A$	40	—	140	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 5A, I_B = 0.5A$	—	—	2.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 5V, I_C = 5A$	—	—	1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 10V, I_C = 1A$	—	15	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	250	—	pF

Note : h_{FE} 区分 / h_{FE} classification R : 40 ~ 80, O : 70 ~ 140